

2SA1121

シリコン PNP エピタキシャル形

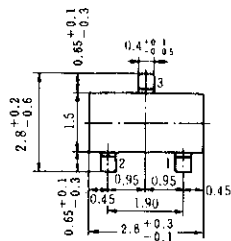
低周波増幅用

2SC2618とコンプリメンタリペア

SILICON PNP EPITAXIAL

LOW FREQUENCY AMPLIFIER

Complementary pair with 2SC2618



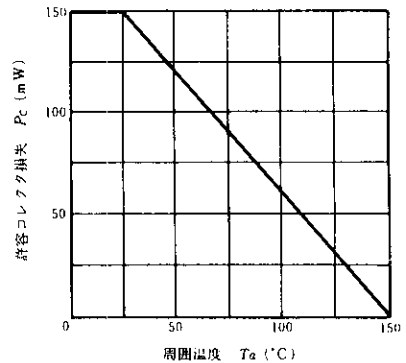
1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

(MPAK)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SA1121	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-35	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-35	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-4	V
コレクタ電流	I_C	-500	mA
許容コレクタ損失	P_C	150	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$	-35	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = -1\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-35	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-4	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = -20\text{V}, I_E = 0$	—	—	-0.5	μA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -150\text{mA}, I_B = -15\text{mA}$	—	-0.2	-0.6	V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = -3\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	60	—	320	
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = -3\text{V}, I_C = -500\text{mA}$ (Pulse Test)	10	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -3\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	—	-0.64	—	V

* 2SA1121は h_{FE} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

* The 2SA1121 is grouped by h_{FE} as follows.

Grade	B	C	D
Mark	S B	S C	S D
h_{FE}	60~120	100~200	160~320

■ 各特性曲線は、2SA673参照。

See characteristic curves of 2SA673.